

トランジスタ

2SD884

# 2SD884

T-33-11

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

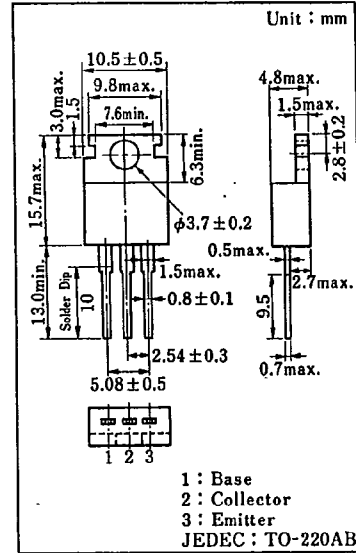
水平偏向出力用 / Horizontal Deflection Output

■ 特徴 / Features

- コレクタ・ベース電圧  $V_{CBO}$  が高い。 / High  $V_{CBO}$
- コレクタ損失  $P_C$  が大きい。 / Large  $P_C$
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	330	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	200	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
非繰返しせん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	15	A
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	10	A
コレクタ電流	$I_C$	7	A
コレクタ損失 ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	40	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 330\text{ V}, V_{EB} = 0$			100	$\mu\text{A}$
		$V_{CE} = 300\text{ V}, V_{EB} = 0, T_a = 100^\circ\text{C}$			1	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 6\text{ V}, I_C = 0$			1	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 5\text{ A}$	10		45	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 0.5\text{ A}$			1	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 0.5\text{ A}$			1.2	V
下降時間	$t_f$	$I_C = 5\text{ A}, I_{B1} = 0.8\text{ A}$ $-V_{EB} = 5\text{ V}, R_B = 0.5\Omega$			0.75	$\mu\text{s}$

T-33-11

